

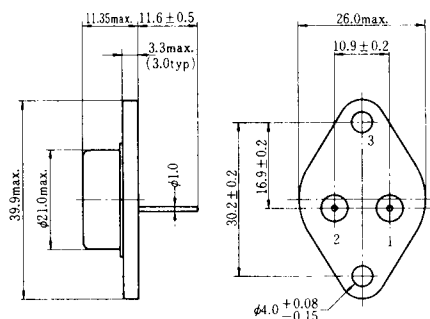
2SD1185, 2SD1186

シリコン NPN 三重拡散形

電力スイッチング用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

POWER SWITCHING



1. ベース:Base
2. エミッタ:Emitter
3. コレクタ:Collector
(ケース) (Case)
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-3)

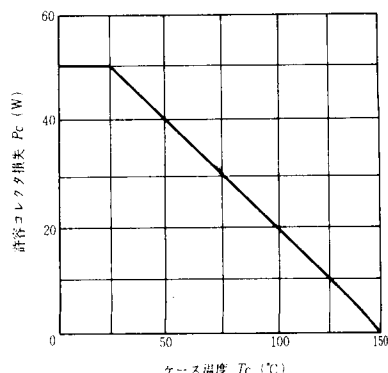
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SD1185	2SD1186	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}		1200	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}		800	800	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}		6	6	V
コレクタ電流	I_C		5	5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$		7	7	A
許容コレクタ損失	P_C^*		50	50	W
接合部温度	T_j		150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		-45~+150	-45~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値、

* Value at $T_C=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$		$I_C=10\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	800	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$		$I_E=10\text{mA}$, $I_C=0$	6	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CES}		$V_{CE}=1200\text{V}$, $R_{BE}=0$	2SD1185	—	0.5	mA
			$V_{CE}=1500\text{V}$, $R_{BE}=0$	2SD1186	—	0.5	mA
直流電流増幅率	h_{FE}		$V_{CE}=5\text{V}$, $I_C=0.3\text{A}$	10	—	30	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$		$I_C=4\text{A}$, $I_B=0.8\text{A}$	—	—	5.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$		$I_C=4\text{A}$, $I_B=0.8\text{A}$	—	—	1.5	V
下降時間	t_f		$I_C=4\text{A}$, $I_{B1}=0.8\text{A}$, $I_{B2}=-2\text{A}$	—	—	1.0	μs
蓄積時間	t_{stg}		$I_C=4\text{A}$, $I_{B1}=0.8\text{A}$, $I_{B2}=-2\text{A}$	—	1.0	—	μs